

MII112

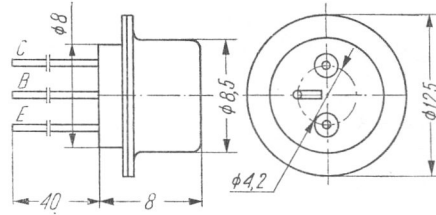
Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: ZSRR

Wykonanie: tranzystor krzemowy stopowy *n-p-n* małej mocy m.cz., w hermetycznej obudowie metalowej

Zastosowanie: układy wzmacniające w urządzeniach powszechnego użytku

Typy podobne: 2N470/471



Rys. 1-1407. MII112

Wartości charakterystyczne¹⁾

I_{CBO}	3	μA	przy $U_C = 5 V$
I_{EBO}	3	μA	przy $U_E = 5 V$
U_{CB0}	10	V	
h_{22b}	2	μS	przy $U_C = 5 V, I_E = 1 mA, f = 1 kHz$
h_{12b}	3	10^{-3}	przy $U_C = 5 V, I_E = 1 mA, f = 1 kHz$
h_{21e}	15 ÷ 45		przy $U_C = 5 V, I_E = 1 mA, f = 1 kHz$
f_{h21b}	0,5	MHz	przy $U_C = 5 V, I_E = 1 mA$
C_c	170	pF	przy $U_C = 5 V, f = 500 kHz$

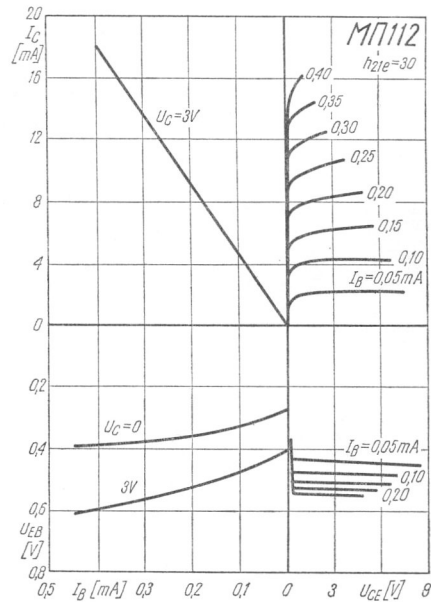
Wartości graniczne

$U_{CER max}$	10 ²⁾	V	$P_{tot max}$	150 ³⁾	mW
$U_{EBO max}$	5	V	$t_j max$	120	$^{\circ}C$
$I_C max$	20	mA	t_{amb}	-55 ÷ +100	$^{\circ}C$
$I_{CM max}$	100	mA			

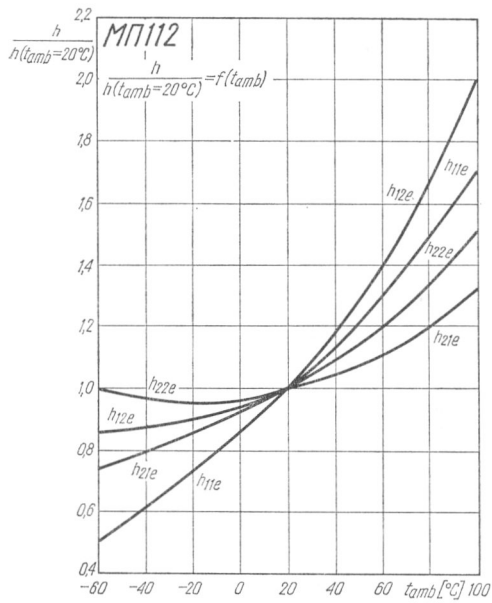
¹⁾ $t_{amb} = 20^{\circ}C (\pm 5^{\circ})$

²⁾ $R_{BE} \leq 2 k\Omega$

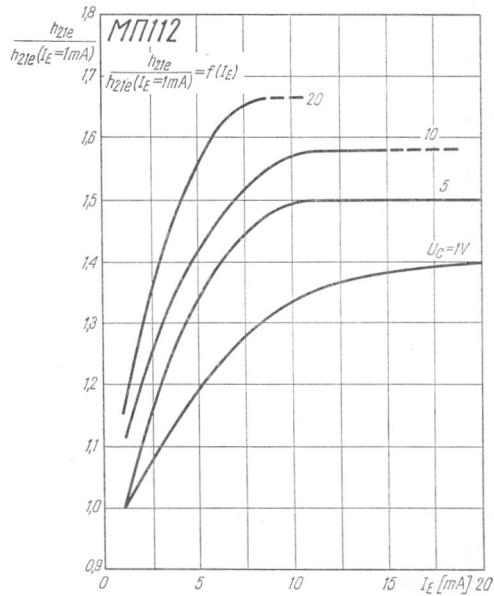
³⁾ $t_{amb} \leq 70^{\circ}C$



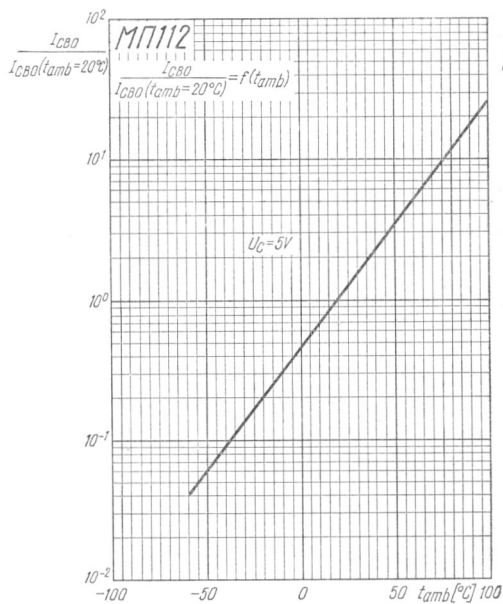
Rys. 1-1408. Charakterystyki statyczne



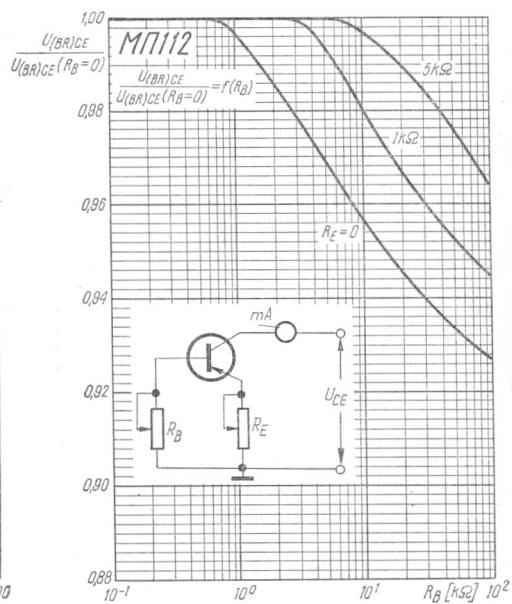
Rys. 1-1409. Zależność parametrów h od temperatury otoczenia



Rys. 1-1410. Zależność parametrów h od prądu emitera



Rys. 1-1411. Zależność znormalizowanego prądu kolektora od temperatury otoczenia



Rys. 1-1412. Zależność znormalizowanego napięcia przebicia kolektora od rezystancji bazy